

今日の課題(2)

- ガウスの法則はどんなことを意味しているのか。
- コンデンサは何をたくわえるのか。
- コンデンサCにおける、電圧 v と電流 i の関係式。

それぞれ自分の理解を文章にまとめながら、講義を聞いて下さい。最後にレポートとして提出します。

2.電界とコンデンサー

A.電気の基礎

電気回路の基本素子の一つがコンデンサーである。英語ではcapacitorキャパシタなので、これからはそう呼ぼう。

抵抗は電気エネルギーを熱に変換した。

キャパシタは電気エネルギーを、電界のエネルギーに変換してため込むことができる。

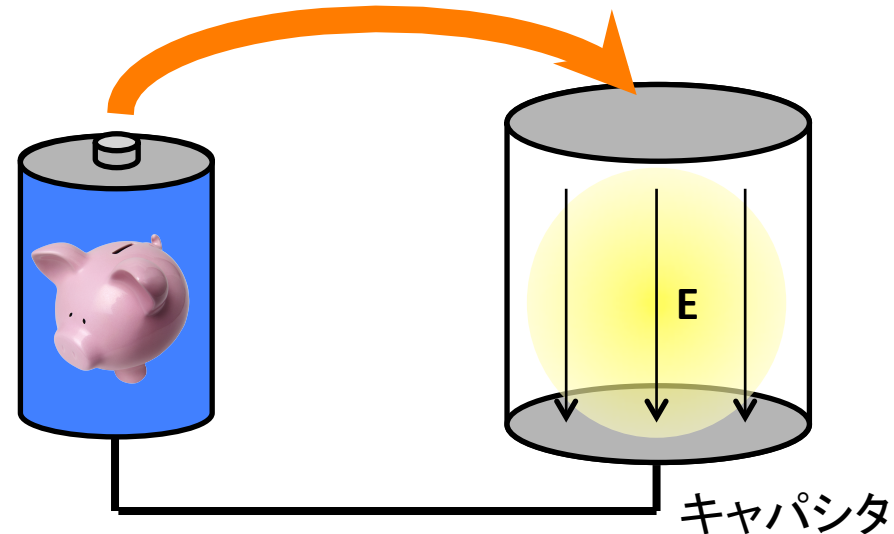
電界Eは、空間に発生する**電気力の強さを表すベクトル量**である。はじめは理論上の量でしかなかったが、空間のひずみとしての実体を持ち、空間にエネルギーをため込む **エネルギー** 事が分かった。

電界にたまったエネルギーは、散逸せずに戻ってくる。

これはバネと似ている。

バネに力が加えられると、バネのひずみとしてエネルギーが蓄えられ、バネを放すとエネルギーが戻ってくる。

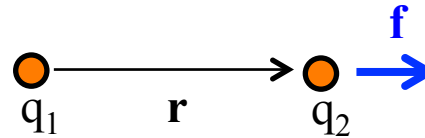
ここではキャパシタの動作を詳しく勉強しよう。



電界Eと電束密度D

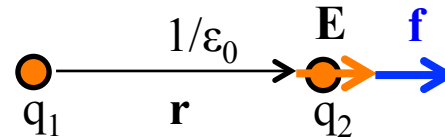
電界Eは電気力を伝える媒質のようなものである。電荷 q_1 が電荷 q_2 に及ぼす電気力 f はクーロンの法則でも表すことができる。

$$\mathbf{f} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$$



でも、クーロンの法則では点電荷同士の力しか分からない。球面上に電荷が分布しているような場合はお手上げだ。そこで電界を考えた。電荷 q_1 は空間に歪みを作る。これが電界Eだ。電界がある空間に来ると、電荷 q_2 には $\mathbf{E}q_2$ の力がかかる。

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q_1}{\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad \mathbf{f} = \mathbf{E}q_2$$



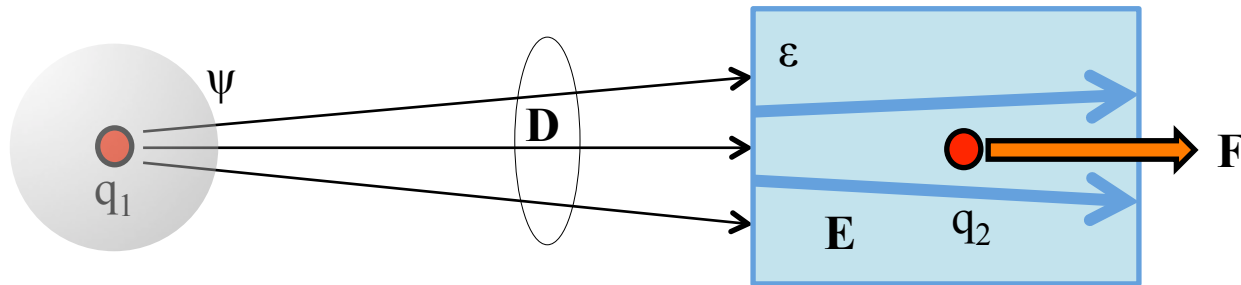
直接の力ではなく、いったん電界を介すると、電気力を空間の性質として考えることができる。空間の性質を「場」と呼ぶ。

実は3つ以上の点電荷の運動は計算することができない(3体問題)。しかし、場の考え方を使えば、ポテンシャル中の点電荷の運動として計算が可能になる。

電界と電束密度の違い

電荷 q_1 は周囲の空間に、電荷量と等しい電気力線の束、電束 ψ を発散している。

電束の密度 D によって作られた空間の歪み E が電荷 q_2 に電気力 F を及ぼす。 D が E を作るときの比例定数を $1/\epsilon$ (誘電率)とする。



電束の総量 ψ は、発生源の電荷量 q_1 に等しいので、電束密度 D を全部足しあわせると、 q_1 になる。
この量は変わらないので、電束密度 D も空間の性質によって変わることはない。

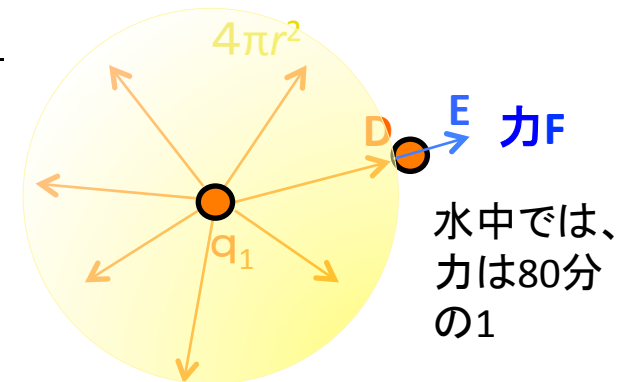
いっぽう、電気力は・・・
水の様な誘電体中で電界は弱まる。
水の誘電率は真空の80倍なので、
電気力は $1/80$ に弱まる。
その分、電界も弱まっている。

電束と電界

電界を使って考えるため、クーロンの法則を便利な形に書き換えよう。
電界の式を見ると、電荷から力の元が湧きだし、距離 r に対して球の面積
($4\pi r^2$)に広がって行く。 q_1 からわき出す量を D とすると、 $1/\epsilon_0$ の大きさで力
 E を発生させる。

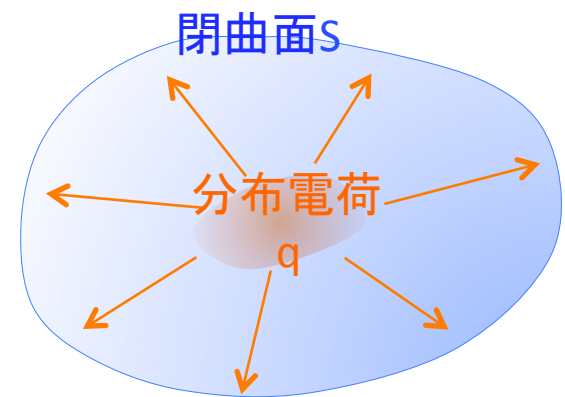
$$E = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q_1}{\epsilon_0} \quad \xrightarrow{\text{分解}} \quad D = \frac{1}{4\pi r^2} q_1 \quad E = \frac{D}{\epsilon_0}$$

電束密度 D は電荷量 q に比例する。
電界 E は電気力に比例する。
似ているけれど別々の量。



D の総量は途中で増えも減りもしない(保存量)。
それが球面に広がるから、面積分の1に弱まる。
この電荷からわき出すものは電束と呼ばれる。
 D は電束の密度である。

分布する電荷でも、そこから出る電束の総量は
電荷量に等しい。なので、任意の閉じた曲面 S 上
を通り抜ける電束の総量は、電荷量に等しい。



ガウスの法則

微小面積 da を抜けていく電束の量を $d\psi$ とする

$$d\psi = \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da$$

電束の S 上の総和 ψ

$$\psi = \int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da$$

S 内の体積 V に存在する電荷の総量 q は

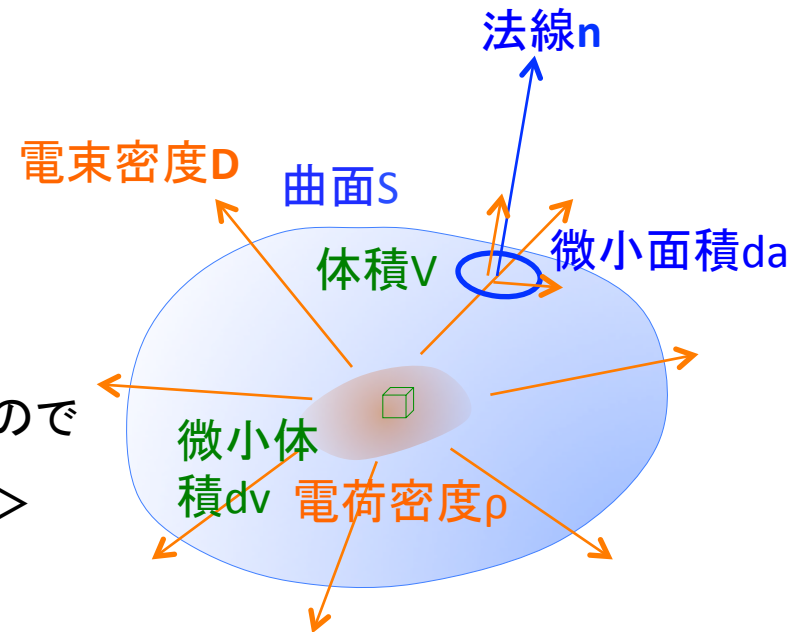
$$q = \int_V \rho dv$$

電束の総量はそれを発する電荷に等しいので

$$\int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = \int_V \rho dv \quad \text{〈ガウスの法則〉}$$

である。この関係をガウスの法則と呼ぶ。

ガウスの法則を正確に書くと



ガウスの法則

電荷から湧き出す電束は、
元になる電荷量に等しい

ガウスの法則を簡単に書くと

\mathbf{D} は電束密度のベクトル、 ρ は電荷密度、 \mathbf{n} は法線ベクトル、 da は S 上の微小面積、 dv は S 内の微小体積、

キャパシタの性質1

距離 d 離れた面積 A の二枚の金属板(極板)に、電荷 $+Q$ と $-Q$ が均一に分布している。この時、二枚の極板の間の電界強度 E と電位差 V を求めてみよう。

近似的に、極板の縁から出る電束量はわずかで、無視できるものとする(極板が d に比べ、非常に広い場合。)すると電束は全て極板に垂直で、両側の面積 A を抜けていく。よって、電束量は $2AD$ である。ガウスの法則によると極板から出る電束の総和は Q である。

$$Q=2AD=2A\epsilon E$$

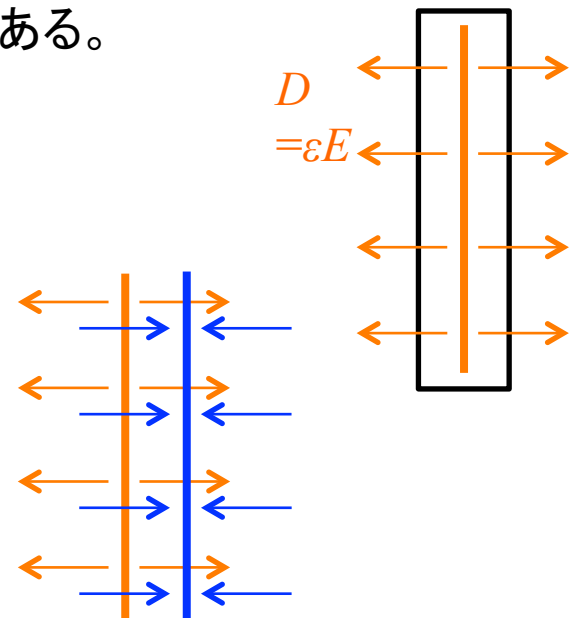
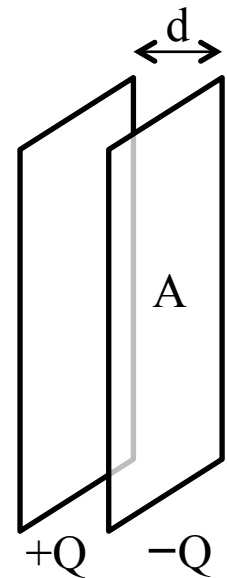
この式から、1つの極板の電荷が作る電界の強度 E は

$$E=Q/2A\epsilon$$

となる。電極の間では電界は足し合わされるので、

$$E=Q/A\epsilon$$

となるが、外側では電界は打ち消しあって0となる。



キャパシタの性質2

電位 ϕ の定義(x は距離)

$$\phi = \int E \cdot dx$$

を使うと、間に均一な電界 E がある距離 d 離れた極板の電位差 V は

$$V = Ed$$

である。まとめると、

$$V = \frac{d}{\epsilon A} Q = \frac{1}{C} Q \quad C = \epsilon \frac{A}{d}$$

の関係が得られる。 C は電気容量と呼ばれるキャパシタの定数である。

電圧×電荷がエネルギーで、それが線形に増加することに注意すると、コンデンサに蓄えられるエネルギー U は、

$$U = QV/2$$

である。 $Q = A\epsilon E$, $V = dE$ を代入すると、

$$U = \epsilon E^2 Ad/2$$

で、体積当たりのエネルギー密度 e は

$$e = \epsilon E^2/2 = DE/2 = D^2/2\epsilon$$

である。キャパシタには電界、または電束の形でエネルギーが蓄えられる。

キャパシタの電流と電圧

電流*i*は単位時間に移動する電荷量*Q*とすると、

$$Q = \int i dt$$

なので、キャパシタにかかる電圧*V*は

$$V = \frac{1}{C} \int i dt$$

のように、電流の積分で表される。

キャパシタにかかる電圧*V_c*は流れた電流*i*の積分の1/*C*倍になる。

$$V_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

コンデンサ1

セラミック



タンタル

やや大容量

スチロール



高速



フィルム

積層
セラ
ミック

コンデンサ2(大容量)



電気二重層
大容量、高速、低圧



固体電解質



ケミコン
大容量、中高圧



オイルコンデンサ
高耐圧



7A72-PXC760
750V DC
1995µF
1953-10
NEC
25

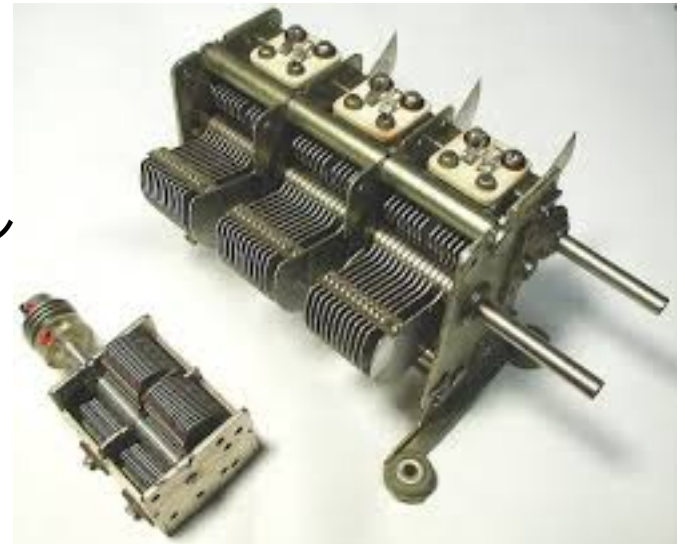
コンデンサ3: 可変



トリマー



エアバリコン



ポリバリコン

電位の定義

電位 ϕ は電界が作る位置エネルギーのようなもの。位置エネルギー U の定義は、力 F に距離 s を掛けたものである。これは一様な力の場合なら正しいが、力の場が場所によって変化する場合は、距離の掛け算ではなく、距離積分になる。式で書くと

$$U = \int \mathbf{F} ds$$

ということになる。だとすると、**電位の定義**は、力の場 E の距離積分ということになる。

$$\phi = \int \mathbf{E} ds$$

これが電位をの正しい定義式である。この積分は3次元のベクトル s の微少量についての積分なので、 (dx, dy, dz) の3成分を含んでいる。よって、以下の様に積分される。

$$\phi = \iiint (E_x, E_y, E_z) \cdot (dx, dy, dz) \quad \Delta\phi = E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z$$

有限な微少量 $\Delta\phi$ を積み上げると積分になる。逆にこの式を微分するには、3次元 (dx, dy, dz) で微分する必要がある。

$$\Delta\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial\phi}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial\phi}{\partial z} \Delta z = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z} \right) \cdot (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

微小ベクトル Δs による、電位の微小変化 $\Delta\phi$ は上記のようになる。この微分は電界ベクトル E を表すはずである。

$$\Delta\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial\phi}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial\phi}{\partial z} \Delta z = E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z$$

つまり、電位 ϕ から電界 E を求めるには、3次元の微分をする必要がある。

演算子

ここでカッコ悪い式が出てきた。

$$\left(\frac{d}{dx} \phi, \frac{d}{dy} \phi, \frac{d}{dz} \phi \right) = (E_x, E_y, E_z)$$

である。数学ではこんな面倒な書き方はしない。電界の3つのベクトル成分はまとめてEと書く。だとしたら、微分もまとめて書く方法はないのか？それが∇である。

$$\nabla = \left(\frac{d}{dx}, \frac{d}{dy}, \frac{d}{dz} \right)$$

∇はナブラと読み、3次元の微分を表す記号である。微分は数学的な操作=演算なので、このような性質の記号を演算子 (Operator) と呼ぶ。

ナブラを使うと、電位 ϕ と電界Eの関係式は

$$\nabla \phi = \mathbf{E}$$

のようにきれいにまとめられる。

演算子の本当の意義は、**演算を変数と同じように**集合の要素として扱う点にある。演算と、演算される側の変数が同じなんて、奇妙な気がするが、計算上は非常に便利なので、のちのち物理の勉強をする人は覚えておくと良い。

ガウスの法則 ふたたび

さてさて、電位 ϕ というスカラー量を微分すると、電界 \mathbf{E} というベクトル量になった。これは、地形のような、高さというスカラー量がある場の傾きを計算すると、傾きは方向毎に求められるのでベクトル量になる、と考えればよい。

では、ベクトル量を微分すると何になるのだろうか？実は、その答えは微分の仕方によって3つある。しかし、ここでは一つだけを紹介しよう。

ベクトル微分 ∇ とベクトル \mathbf{E} の内積をとってみよう。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \quad \text{発散 : Divergence}$$

これは、各成分毎に微分している。ベクトルの一成分(たとえば E_x)は方向を持った流れのようなものである。それが微小距離 dx 進んだとき、どれだけ変化するか？ということは、流れが増えたか減ったかを示す量である。つまり、**流れを生み出すもの**があれば、それがこの微分量を増やすことになる。この流れを生み出す量のことを**発散**と呼ぶ。

力線 $\epsilon\mathbf{E}$ の流れを生み出すものは電荷である。発散は電荷量を表すはずだ。電荷の密度を ρ とすれば、

$$\nabla \cdot \epsilon\mathbf{E} = \rho$$

であろう。

ダイバージェンス

前項の議論に従って、電界ベクトル \mathbf{E} のダイバージェンス $\text{div}\mathbf{E}$ を次のように定義する。

$$\text{div}\mathbf{E} \equiv \nabla \cdot \mathbf{E} = \left(\frac{dE_x}{dx} + \frac{dE_y}{dy} + \frac{dE_z}{dz} \right)$$

ダイバージェンスは流れのベクトル \mathbf{E} の変化分(増加)を、 x, y, z の3方向について計算して足し合わせた量だ。

これに微小体積 $dx dy dz$ を掛けると、その体積からわき出す流れの量が得られる。

ガウスの法則によると、電束 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ の全表面積分(=内部から出てくる量)は内部の電荷量に比例する。

だとすると、微小体積から流れ出すわき出し量は内部の電荷密度を ρ として、 $\rho dx dy dz$ とすることになる。

$$\epsilon \text{div}\mathbf{E} dx dy dz = \rho dx dy dz$$

よって、電界の発散(ダイバージェンス)は、 ρ/ϵ に等しいことになる。

$$\text{div}\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \qquad \text{div}\mathbf{D} = \rho$$

これはガウスの法則の別表現(微分表記)である。

ガウスの定理を用いると、以下の様に積分表記に変換できる。

$$\int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = \int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dv \qquad \int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = \int_V \rho dv$$

ガウスの法則のまとめ

- ガウスの法則とは、「電荷からわき出す電束の総量は電荷量に等しい。」である。
- 積分型 $\int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = \int_V \rho dv$ 微分型 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$
- ベクトル量 \mathbf{D} のダイバージェンスは以下の様に定義され湧きだしの大きさを表す。

$$\text{div} \mathbf{D} \equiv \nabla \cdot \mathbf{D}$$

- ガウスの定理

$$\int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = \int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dv$$